

ПРОТОКОЛ № 1/2021
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

15 марта 2021 г.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------|---|
| Председатель комиссии | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе |
| Секретарь комиссии | - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН - Р.А. Хабибуллин |
| Члены комиссии: | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар»
- Ю.В. Колковский |
| | - член-корреспондент РАН, директор ФТИАН имени В.К.Валиева РАН - В.Ф. Лукичев |
| | - главный научный сотрудник, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ», доктор технических наук - Д.В.Громов. |

Всего: 6 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности заместителя директора по научной работе.

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Пономарева Дмитрия Сергеевича для избрания его на должность заместителя директора по научной работе. Директор зачитал характеристику Пономарева Д.С., подписанную научным руководителем Института Мальцевым П.П. В ней, в частности отмечается, что Пономарев Д.С. специалист в области квантово-размерных гетероструктур АЗВ5 и приборов на их основе для полупроводниковой сверхвысокочастотной электроники, в том числе для терагерцовой области спектра частот (0,1–10 ТГц). Основные научные результаты Пономарева Д.С.:

- разработана технология создания транзисторов с высокой подвижностью электронов (HEMT-high electron mobility transistor) с рекордными частотами отсечки по мощности до 650 ГГц;

- разработана концепция создания фотопроводящих антенн для генерации и детектирования ТГц излучения на основе низкотемпературных полупроводников с частотами генерации до 3 ТГц;

- разработаны и исследованы гетероструктуры с составными квантовыми ямами InGaAs со вставками InAs и/или GaAs. Впервые показана возможность уменьшения эффективной массы носителей тока в таких структурах.

В 2014 г. Д.С. Пономарев стал победителем Летней школы Открытого университета Сколково (ОтУС) для молодых организаторов науки, организованной совместно ФАНО России и ОтУС, а в 2011 г. стал победителем Фонда поддержки образования и науки имени чл.-корр. РАН, проф. Мокерова В.Г. В 2018 г. была присуждена медаль за работу «Разработка и исследование квантово-каскадных лазеров терагерцового диапазона частот». В 2020 г. Пономарев Д.С. успешно окончил обучение в МШУ Сколково по программе «Лидеры научно-технологического прорыва». Д.С. Пономарев является экспертом РАН с 2016 г. (согласно Распоряжению Президиума РАН от 27.07.2016 № 10108-509) и экспертом РНФ (договор № 09-17/5937 от 06.08.2020).

В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Пономарев Д.С. выполнял различные исследовательские задачи как экспериментального, так и теоретического характера, руководил научной и образовательной деятельностью Института и участвовал в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ИСВЧПЭ РАН, в том числе в должности руководителя.

Пономарев Д.С. является автором 100 научных работ, в том числе 7 патентов. Результаты исследований неоднократно представлялись Пономаревым Д.С. на отечественных и международных научных конференциях

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

2. Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности заместитель директора по научной работе состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании бальной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- заместителя директора по научной работе – Пономарева Дмитрия Сергеевича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.



С.А. Гамкрелидзе

Р.А. Хабибуллин

«15» марта 2021 г.